

Silicon Dual Schottky Diode

S465D

6V / 200mA

DATASHEET

OEM – Telefunken

Source: Telefunken Databook 1988

S 465 D**GaAs-Schottky Diodenpaar**

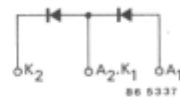
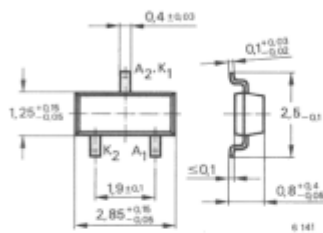
Vorläufige technische Daten für Muster

Anwendung: Ringmodulatoren

Besondere Merkmale:

- Geringe Durchlaßspannung
- Geringe Durchlaßspannungsdifferenzen
- Geringer Durchlaßwiderstand
- Geringe Kapazitäten

Abmessungen in mm



Standard Kunststoffgehäuse
23 A3 DIN 41869/8
SOT 23
Gewicht max. 0,01 g

Bestemp lung: 465

Absolute Grenzdaten

für Einzeldiode falls nicht anders angegeben

Sperrspannung	U_R	6	V
Spitzendurchlaßstrom	I_{FM}	200	mA
Gesamtverlustleistung $T_{amb} \leq 25 \text{ °C}$	P_{tot}	200	mW
Sperrschichttemperatur	T_j	125	°C
Umgebungstemperaturbereich	T_{amb}	-55 ... +125	°C
Lagerungstemperaturbereich	T_{stg}	-55 ... +125	°C

Kenng rößen

für Einzeldiode

		Min.	Typ.	Max.	
Sperrstrom				50	μA
$U_R = 4 \text{ V}$	I_R				
Durchlaßstrom	I_F			200	mA
Durchlaßspannung					
$I_F = 1 \text{ mA}$	U_F	620			mV
$I_F = 10 \text{ mA}$	U_F			820	mV
Differentieller Durchlaßwiderstand					
$I_F = 5 \text{ mA}$	r_f			15	Ω
Diodenkapazität					
$U_R = 0, f = 1 \text{ MHz}$	C_D		700		fF

S 465 D